

Title (en)

Reflector for semiconductor light sources

Title (de)

Reflektor für Halbleiterlichtquellen

Title (fr)

Réflecteur pour sources lumineuses semi-conductrices

Publication

EP 2587132 A2 20130501 (DE)

Application

EP 12189928 A 20121025

Priority

DE 102011085418 A 20111028

Abstract (en)

The reflector (1) has a light source point (5) which is provided at the center of emitting surface (8) of light source (6). The light source is provided in a recess (7) such that center of emitting surface of light source is in correspondence with light source point. The facets are provided with a curved surface. The radius of curvature of facets is varied in transverse and longitudinal directions. The spacing between the facets is in correspondence with the spacing between the midpoint of facet and light source point.

Abstract (de)

Um bei einem Reflektor für Halbleiterlichtquellen, insbesondere für ein Downlight, der einen durch eine Reflektorumwandung begrenzten Innenraum sowie eine Lichtaustrittsseite umfasst, die an einem Längsende des Reflektors angeordnet ist und an der der Innenraum offen ist, wobei in dem Innenraum und in Querrichtung des Reflektors umfänglich von der Reflektorumwandung umgeben ein Lichtquellenpunkt (5) vorgesehen ist, an dem ein Mittelpunkt einer emittierenden Fläche (8) einer Lichtquelle (6) in dem Reflektor anordenbar ist, wobei die Reflektorumwandung eine Aussparung aufweist, durch die eine in dem Reflektor angeordnete Lichtquelle elektrisch kontaktierbar und fixierbar ist, wobei an der dem Innenraum zugewandten Innenseite der Reflektorumwandung Facetten (9) angeordnet sind, die eine reflektierende und in Längsrichtung und/oder Querrichtung gewölbte Oberfläche aufweisen, zu vermeiden, dass die Lichtdurchmischung in dem Reflektor gerade durch die Aufweitung des von der Halbleiterlichtquelle emittierten Lichtstrahls über die Streuung an den Facettenoberflächen erreicht wird schlägt die Erfindung vor, dass der der Wölbung in Längsrichtung zugeordnete Krümmungsradius der Facetten, gemittelt über sämtliche Facetten, deren Oberflächenmittelpunkt denselben Abstand von dem Lichtquellenpunkt hat, in Abhängigkeit von diesem Facettenabstand variiert.

IPC 8 full level

F21V 7/04 (2006.01); **F21V 7/09** (2006.01)

CPC (source: EP US)

F21V 7/048 (2013.01 - EP US); **F21Y 2115/10** (2016.07 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2587132 A2 20130501; **EP 2587132 A3 20140618**; **EP 2587132 B1 20171025**; DE 102011085418 A1 20130502

DOCDB simple family (application)

EP 12189928 A 20121025; DE 102011085418 A 20111028